

(12) 特許協力条約に基づいて公開された国際出願

訂正版

(19) 世界知的所有権機関
国際事務局

(43) 国際公開日
2025年5月22日(22.05.2025)



(10) 国際公開番号

WO 2025/105310 A9

(51) 国際特許分類:
C23C 14/34 (2006.01) C23C 14/14 (2006.01)

(21) 国際出願番号: PCT/JP2024/039840

(22) 国際出願日: 2024年11月8日(08.11.2024)

(25) 国際出願の言語: 日本語

(26) 国際公開の言語: 日本語

(30) 優先権データ:
特願 2023-193867 2023年11月14日(14.11.2023) JP

(71) 出願人: J X 金属株式会社 (JX ADVANCED METALS CORPORATION) [JP/JP]; 〒1058417 東京都港区虎ノ門二丁目10番4号 (JP).

(72) 発明者: 守岡 明良 (MORIOKA, Akira); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 (JP). 西村 康佑 (NISHIMURA, Kosuke); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 (JP). 太齋 貴文 (DASAI, Takafumi); 〒3191535 茨城県北茨城市華川町白場187番地4 J X 金属株式会社磯原工場内 (JP).

(74) 代理人: アクシス国際弁理士法人 (AXIS PATENT INTERNATIONAL); 〒1050004 東京都港区新橋二丁目6番2号新橋アイマークビル (JP).

(81) 指定国(表示のない限り、全ての種類の国内保護が可能): AE, AG, AL, AM, AO, AT, AU, AZ, BA, BB, BG, BH, BN, BR, BW, BY, BZ, CA, CH, CL, CN, CO, CR, CU, CV, CZ, DE, DJ, DK, DM, DO, DZ, EC,

EE, EG, ES, FI, GB, GD, GE, GH, GM, GT, HN, HR, HU, ID, IL, IN, IQ, IR, IS, IT, JM, JO, JP, KE, KG, KH, KN, KP, KR, KW, KZ, LA, LC, LK, LR, LS, LU, LY, MA, MD, MG, MK, MN, MU, MW, MX, MY, MZ, NA, NG, NI, NO, NZ, OM, PA, PE, PG, PH, PL, PT, QA, RO, RS, RU, RW, SA, SC, SD, SE, SG, SK, SL, ST, SV, SY, TH, TJ, TM, TN, TR, TT, TZ, UA, UG, US, UZ, VC, VN, WS, ZA, ZM, ZW.

(84) 指定国(表示のない限り、全ての種類の広域保護が可能): ARIPO (BW, CV, GH, GM, KE, LR, LS, MW, MZ, NA, RW, SC, SD, SL, ST, SZ, TZ, UG, ZM, ZW), ユーラシア (AM, AZ, BY, KG, KZ, RU, TJ, TM), ヨーロッパ (AL, AT, BE, BG, CH, CY, CZ, DE, DK, EE, ES, FI, FR, GB, GR, HR, HU, IE, IS, IT, LT, LU, LV, MC, ME, MK, MT, NL, NO, PL, PT, RO, RS, SE, SI, SK, SM, TR), OAPI (BF, BJ, CF, CG, CI, CM, GA, GN, GQ, GW, KM, ML, MR, NE, SN, TD, TG).

添付公開書類:

- 国際調査報告(条約第21条(3))
- 規則91.3(b)の規定に基づく明白な誤記の訂正の許可に関する情報(規則48.2(i))

(48) この訂正版の公開日: 2025年11月27日(27.11.2025)

(15) 訂正情報: 2025年11月27日(27.11.2025) の更新情報 (Notice) を参照

(54) Title: SPUTTERING TARGET ASSEMBLY AND FILM

(54) 発明の名称: スパッタリングターゲット組立体及び膜

(57) Abstract: The purpose of the present disclosure is to provide a tungsten sputtering target assembly using a target having a low flexural strength. In one aspect, the present disclosure provides the following invention. This sputtering target assembly comprises a target, a backing plate, and an insert, wherein: the target is composed of W; the backing plate contains Ti or a Ti alloy; the insert contains Cu or a Cu alloy; and the flexural strength of the target is at most 350 MPa.

(57) 要約: 本開示は、抗折強度の低いターゲットを用いたタングステンスパッタリングターゲット組立体を提供することを目的とする。一側面において、本開示は以下の発明を提供する。ターゲットと、バックキングプレートと、インサートとを備えるスパッタリングターゲット組立体であって、前記ターゲットはWから成り、前記バックキングプレートはTi又はTi合金を含み、前記インサートはCu又はCu合金を含み、前記ターゲットの抗折強度は350MPa以下である、スパッタリングターゲット組立体。

WO 2025/105310 A9